

MPPC®





MPPC (Multi-Pixel Photon Counter)は、Si-PM (Silicon Photomultiplier)と呼ばれるデバイスの1種で、 ガイガーモードAPDをマルチピクセル化した新しいタイ プのフォトンカウンティング (光子計測)デバイスです。光 半導体素子でありながら、優れたフォトンカウンティング 能力をもっており、フォトンカウンティングレベルの微弱光 を検出するさまざまな用途に利用することができます。

MPPCは、低電圧で動作し、高い増倍率、高い検出効 率、高速応答、優れた時間分解能、広い感度波長範囲と いった特長があり、フォトンカウンティングにおいて必要 とされる性能を高いレベルで実現しています。さらに、磁 場の影響を受けない、衝撃などに強い、入射光の飽和に よる焼き付きがないという固体素子ならではの優位性も あり、従来からフォトンカウンティングに用いられてきた 検出器に代わる大きな可能性をもっています。動作が容 易で高性能な検出素子であるMPPCは、医療・学術・計 測などの広い分野で応用が期待されます。¹⁾²⁾³⁾

. 動作原理

1-1 フォトンカウンティング

光には、粒子と波の2重性があります。光量が極端に 少なくなると、光はフォトン(光子)として離散的になり、そ の数を数えることができます。フォトンカウンティングは、 フォトンを1個ずつ計測する技術です。

MPPCは、非常に優れた時間分解能と、高増倍率で低 ノイズの増倍機能をもち、フォトンカウンティングに適して います。微弱光計測においてフォトンカウンティングは、 出力電流値をアナログ的に測定する方法に比べると、高 S/Nと安定した測定を実現することができます。

1 - 2 ガイガーモードとクエンチング抵抗

APDの逆電圧を降伏電圧以上にして動作させると、

光量の大小に関係なく光入射によって素子固有の飽和 出力が発生します(ガイガー放電)。この電圧でAPDを 動作させる状態をガイガーモードと呼びます。ガイガー モードにおいては、1フォトンの検出時においても放電現 象により大きな出力が得られることが特長であり、ひとた びガイガー放電が始まると素子内部の電界が保たれる 間は放電が継続します。

ガイガー放電を止めて、次のフォトンを検出するため には、動作電圧を下げるためAPDに外部回路を設ける 必要があります。ガイガー放電を止める具体的な例とし て、ガイガーモードで動作するAPDにクエンチング抵抗 を直列に接続し、APDのアバランシェ増倍を短時間で停 止する方法があります。この方法では、ガイガー放電によ る出力電流がクエンチング抵抗を流れる際に電圧降下 を起こし、直列に接続されたAPDの動作電圧が下がりま す。ガイガー放電による出力電流は鋭い立ち上がりのパ ルス形状で、クエンチング抵抗によるガイガー放電停止 時の出力電流の立ち下がりは、比較的なだらかなパルス 形状となります [図1-4]。

1-3 構造

MPPCの構成を図1-1に示します。MPPCは、ガイガー モードAPDとクエンチング抵抗を組み合わせたものを基 本単位 (1ピクセル)とし、多数のピクセルを2次元に電気 的接続をした構造をもっています。

[図1-1] 構成



[図1-2] MPPCによるフォトンカウンティングのイメージ



KAPDC0049JA

[図1-3] MPPC評価用のブロック図 (オシロスコープを使用)



1-4 基本動作

MPPCのピクセルは、それぞれがフォトンの検出時に 同じパルスを出力します。複数のピクセルで発生したパ ルスは、重ね合わされて出力されます。たとえば、4フォト ンが別々のピクセルに同時に入射して検出された場合、 MPPCからは4つのパルスが重ね合わされた高さの信号 が出力されます。

各ピクセルからの出力パルス数は1つであり、入射フォ トン数によって変化しません。1ピクセルに1フォトンが 入った場合も、2フォトンが同時に入った場合も出力パル スは1つだけです。このことは、MPPCに入射するフォト ンの数が増え、1ピクセルに入射するフォトン数が複数 になった場合、入射フォトン数に対するMPPC出力の直 線性が悪化することを意味します。入射フォトン数に見 合ったピクセル数のMPPCを選択することが重要です。

MPPCが検出したフォトンの数を見積もるために、以下の2つの方法があります。

- ・パルスを観測
- ・出力電荷を計測

(1) パルスを観測

光が、あるタイミングでMPPCに入射する場合、検出し たフォトン数に応じて出力パルスの高さが変わります。図 1-4は、MPPCにフォトンカウンティングレベルの光をパル ス照射して、リニアアンプで増幅した出力をオシロスコー プで観測した例です。1フォトン、2フォトン~と検出した フォトン数ごとにパルスが分離していることが分かりま す。このパルスの高さを測定することによって、検出した フォトンの数を見積もることができます。

[図1-4] リニアアンプを用いたパルス波形 (S13360-3050CS)



(2) 出力電荷を計測

チャージアンプなどを用いてMPPCからの出力電荷量 を計測することによって、特定期間に検出したフォトン数 の分布を見積もることが可能です。積算された電荷量の 出力を弁別すると図1-5のような分布が得られます。ピー ク値は、左からペデスタル、1フォトン、2フォトン、3フォト ン~に対応します。MPPCは高増倍率のため出力電荷 量が多く、検出フォトン数に応じた離散的な分布を示し ています。

[図1-5] チャージアンプを用いたパルス波高スペクトル (S13360-1350CS)



KAPDB0133JB

. 特長



MPPCによるフォトン検出時に、出力パルスとは別に遅 れて再び信号が出力されることがあります。これをアフ ターパルスと呼んでいます。最新のMPPCは、材料やウエ ハプロセス技術を改善することによって、従来品に比べて アフターパルスの大幅な低減を実現しました。アフターパ ルスの低減はS/N向上だけでなく、動作電圧範囲の拡大、 高電圧領域での時間分解能特性や検出効率の向上な ど、さまざまなメリットをもたらします。

[図2-1] アフターパルスーオーバー電圧 (S13360-3050CS)



MPPCは、 λ =400~500 nm付近に感度のピーク をもっています。MPPCの感度は検出効率(Photon Detection Efficiency: PDE)と呼ばれ、量子効率・開口 率・アバランシェ確率の積から求められ、このうちアバ ランシェ確率は電圧依存性をもちます。25 µmピッチの MPPCでは開口率の高い設計を採用し、従来品と比べ 検出効率を大幅に改善しました。さらに同様の設計で 10 µm・15 µmピッチの製品も実現し、高速応答・広ダイ ナミックレンジと高検出効率を両立させています。なお50 µm・100 µmピッチの開口率は従来品と同じですが、オー バー電圧を上げることで検出効率は改善されます。

03

[図2-2] 検出効率-オーバー電圧



注) 検出効率は、クロストークとアフターパルスを含みません。

KAPDB0217JC

[表2-1] 推奨オーバー電圧

| ピクセルピッチ (µm) | 推奨オーバー電圧 (V) | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|------------|--|
| | 従来品 S12571/ S12572シリーズ | S13360シリ <i>ー</i> ズ | S14160シリーズ | |
| 10 | 4.5 | - | 5 | |
| 15 | 4 | - | 4 | |
| 25 | - | 5 | - | |
| 50 | - | 3 | - | |
| 75 | - | 3 | - | |

 $Vov = Vop - V_{BR} \cdots (2-1)$

Vov: オーバー電圧 Vop: 動作電圧 VBR: 降伏電圧

- 3 広いダイナミックレンジ 2

MPPC のダイナミックレンジは、ピクセル数とピクセル の回復時間によって決定されます。最小10 µmのピクセ ルピッチを実現することで、単位面積当たりのピクセル数 を増すとともに、回復時間を短縮して、ダイナミックレンジ の飛躍的な拡大を実現しました。

[図2-3] パルス波形 (S14160-1310PS)



2-4 低クロストーク

フォトンを検出したピクセルが他のピクセルに影響し、 出力パルスとは別のパルスを同時に発生させることがあ ります。これをクロストークと呼んでいます。精密計測用の MPPCでは、ピクセル間に障壁を設けることで、クロストー クの大幅な低減を実現しました。

[図2-4] パルス波形 (a) 従来品 (ピクセルピッチ: 50 µm)



(b) 低クロストークタイプ (S13360-3050CS)



[図2-5] クロストーク - オーバー電圧



04

2-5 金属クエンチング抵抗

金属クエンチング抵抗の採用により、抵抗値の温度係 数が従来の1/5に低減されました。その結果、特に低温 時において、パルスの立ち下がりの変化が抑えられ出力 波形が改善されます。

使用可能な温度範囲については、データシートを参照 してください。



KAPDB0258JA

特性 3.

MPPCのタイプと特性 3 - 1

さまざまな用途に対応できるように、豊富なピクセル サイズ・受光面サイズのMPPCを取りそろえています。 パッケージとしては、メタル、セラミック、PWB (Printed Wiring Board)、CSP (Chip Size Package)などを用意し ています。また、多チャンネルアレイとして、チャンネルご との特性が均一で、チャンネル間デッドスペースの狭い MPPCアレイも用意しています。

高い増倍率・検出効率を必要とする用途には、ピクセ ルサイズの大きいタイプが適しており、高速応答・広ダイ ナミックレンジを必要とする用途にはピクセルサイズの小 さいタイプが適しています [表3-1]。また、受光面サイズ が大きいタイプは広ダイナミックレンジの計測や広い入 射範囲の光検出に適しており、受光面サイズが小さいタ イプは高速応答・低ダークカウントを必要とする用途に 適しています [表3-2]。

MPPCは、動作電圧によって特性が変化します「表 3-3]。さまざまな用途に合った動作電圧の設定ができ るように、MPPCは広い動作電圧範囲をもっています。 高増倍率・高検出効率・高時間分解能が要求される用 途に対しては動作電圧を高めに設定し、低ノイズ(ダー ク、クロストーク、アフターパルスなど)が要求される用 途に対しては動作電圧を低めに設定することによって、 MPPCは最良のパフォーマンスを発揮します。

[表3-1] ピクセルサイズの異なるMPPCの特性

| ピクセルサイズ | 小 ◀───► 大 |
|-----------|-----------|
| 増倍率 | |
| 検出効率 | |
| ダイナミックレンジ | |
| 高速応答性 | |

[表3-2] 受光面サイズの異なるMPPCの特性

| 受光面サイズ | 小 ◀───► 大 |
|-----------|-----------|
| ダイナミックレンジ | |
| 大面積の光検出 | |
| 高速応答性 | |
| 低ダークカウント | |

[表3-3] 動作電圧の異なるMPPCの特性





(1) 定義

MPPCの増倍率は、1ピクセルが1フォトンを検出して 発生したパルスの電荷量(Q)を、1電子当たりの電荷量 (q: 1.602 × 10⁻¹⁹ C)で割った値で定義されます。

 $M = \frac{Q}{q} \dots (3-1)$ $M: \quad \text{Here}$

Qは逆電圧 (VR)と降伏電圧 (VBR)に依存し、式 (3-2) で表されます。

$$Q = C \times (V_R - V_{BR}) \cdots (3-2)$$

C: 1ピクセルの容量

式 (3-1)(3-2)は、ピクセル容量が大きいほど、逆電圧 が高いほど、増倍率が高くなることを示しています。一方 で、逆電圧の上昇により、ダークやアフターパルスなどの 特性も変化します。用途に応じて、逆電圧を設定する必 要があります。

(2) 直線性

MPPCの増倍率は、オーバー電圧を上げると、ほぼ直線的に上昇します。図3-1に代表例を示します。





(3) 温度特性

MPPCの増倍率には、APDと同様に温度特性がありま す。温度が上がると結晶の格子振動が激しくなり、加速 されたキャリアのエネルギーが十分に大きくならないうち に結晶と衝突する確率が高くなり、連続したイオン化が 起こりにくくなります。イオン化が起こりやすくするために は、逆電圧を上昇させて素子内部の電界を高める必要 があります。増倍率を一定にするためには、周囲温度に 合わせて逆電圧を変化させるか、素子温度を一定に保 つ必要があります。

図3-2は、周囲温度が変化する場合、増倍率を一定に するために必要な逆電圧の例を表しています。

[図3-2] 逆電圧-周囲温度 (S13360-3050CS)



KAPDB0227JB

図3-3は、逆電圧を一定にした場合の、増倍率と周囲 温度の関係の例を示します。

[図3-3] 増倍率-周囲温度 (S13360-3050CS)



KAPDB0228JB

3-3 ダークカウントレート

(1) 定義

MPPCではAPDと同様に、光によって生成されたキャ リアだけではなく、熱的に発生したキャリアによってもパ ルスが発生します。このパルスをダークパルスと呼びま す。ダークパルスは信号とともに観測され、検出誤差の 原因となります。また、熱的に発生したキャリアも一定の 信号(1 p.e.)に増倍されます。入射フォトンによるパルス とダークパルスは、パルス形状からは区別がつきません [図3-4]。

[図3-4] ダークパルス



観測されたダークパルスの数をダークカウントと呼び、 1秒当たりのダークパルスの数をダークカウントレート [単位: cps (counts per second)]と定義します。当社の MPPCでは、暗状態において0.5 p.e.の閾値を超えるパ ルスの数でダークカウントレートを定義し、No.5 p.e.と表し ます。

(2) 温度特性

熱的に発生するキャリアによってダークパルスが発生 するため、ダークカウントレートは周囲温度によって変化 します。ダークカウントレートは、動作温度範囲において 式 (3-3)のように表されます。

No.5 p.e.(T)
$$\approx AT^{\frac{3}{2}} exp\left[\frac{-Eg}{2k T}\right]$$
 (3-3)
T : 絶対温度 [K]
A : 任意定数
Eg: バンドギャップエネルギー [eV]
k : ボルツマン定数 [eV/K]

図3-5は、増倍率が一定の場合の、ダークカウントレートの周囲温度依存性を示します。

[図3-5] ダークカウントレートー周囲温度 (S13360-3050CS)





MPPCの1ピクセルに光が入射したときに、2 p.e.以上 のパルスが観測されることがあります。これは、MPPCの ピクセルでアバランシェ増倍が行われる過程で2次フォ トンが発生し、このフォトンを他のピクセルが検出する ことによります。この現象を光学的クロストークと呼びま す。

[図3-6] クロストークの観測例



時間

当社は、クロストーク確率 (Pcrosstalk)を式 (3-4)のよ うに定義しています。

$$Pcrosstalk = \frac{N_{1.5 p.e.}}{N_{0.5 p.e.}} \dots (3-4)$$

クロストーク確率は、動作温度範囲でほとんど温度依存性がありません。また、オーバー電圧が高いほど、クロストークの発生頻度は高くなります[図3-7]。





MPPCのピクセルでアバランシェ増倍する過程で、結 晶欠陥にキャリアが捕獲されることがあります。このキャ リアが放出されると、入射フォトンによるキャリアとともに アバランシェ増倍され、アフターパルスとして観測されま す。入射フォトンによるパルスとアフターパルスは、パル ス形状からは区別がつきません。

[図3-8] アフターパルスの観測例



時間



暗状態において出力される電流を暗電流と呼びます。 MPPCの暗電流 (I_D)は、式 (3-5)のように表されます。

 $I_{D} = I_{S} + I_{j} + I_{b} \cdots (3-5)$

Is: 表面リーク電流 Ij : 再結合電流 Ib: バルク電流

MPPCがガイガーモードにあるときのバルク電流は、 単位時間当たりにアバランシェ増倍が発生したピクセル 数をNfiredとすると式 (3-6)で表されます。

- $Ib = q M N fired \dots (3-6)$
 - q:1電子当たりの電荷量 M:増倍率

MPPCの増倍率は10⁵~10⁶倍のため、式 (3-5)ではIb が支配的となり、式 (3-5)は式 (3-7)のように近似するこ とができます。

 $I_D \approx Ib = q M \text{ Nfired} \dots (3-7)$

暗状態においては、アバランシェ増倍を起こしたピク セルの数はダークカウントレートと一致するため、暗電流 IDはNo.5 p.e.とPcrosstalkを用いて式(3-8)のように近似 されます。特定の逆電圧における増倍率とクロストーク 確率が分かっている場合、ダークカウントレートから暗電 流を、暗電流からはダークカウントレートのおおよその値 を見積もることができます。

 $I_D \approx q M N_{0.5 p.e.} \frac{1}{1 - Pcrosstalk} \dots (3-8)$

3-7 受光感度、検出効率

MPPCの光検出感度を表す特性として、受光感度と検 出効率があります。受光感度は、入射光を連続光として MPPCに入射した場合の、入射光量に対するMPPCの出 力電流(アナログ値)の比で表されます。検出効率は、パ ルス光をMPPCに入射してフォトンカウンティングを行っ たときに、入射フォトン数に対して検出できるフォトン数 の割合を示します。なお、受光感度および検出効率に関 するパラメータとして、開口率・量子効率・アバランシェ 確率があります。

開口率は、MPPCのピクセル領域全体に占める光検出 可能部分の割合です。フォトダイオードやAPDと異なり、 MPPCの受光面にはピクセル間配線など光を検出でき ない部分があるため、受光面に入射したフォトンの一部 は検出されません。一般的にピクセルサイズが小さいほ ど、開口率は低くなる傾向にあります。

量子効率は、ピクセルに入射した光がキャリアを生成 する確率として定義されます。量子効率は他の光半導 体素子と同様に、入射光の波長に依存します。

アバランシェ確率は、光電効果によりピクセル内で生成されたキャリアがアバランシェ増倍を起こす確率です。MPPCに印加する逆電圧が高いほど、アバランシェ確率は高くなります。

(1) 受光感度

受光感度 S (単位: A/W)は、入射光量 (単位: W)に 対する光電流の割合で、式 (3-9)で表されます。

IMPPC: 光電流 [A]

受光感度は増倍率に比例するため、MPPCに印加す る逆電圧が高いほど受光感度は大きくなります。なお、 受光感度にはクロストークやアフターパルスが含まれて いることに注意する必要があります。

(2) 検出効率

検出効率 (PDE)は、入射したフォトンのうち何%を検 出できるかを示す特性であり、式 (3-10)で表されます。

検出効率は、開口率・量子効率・アバランシェ確率の 積で表すことができます。

 $PDE = Fg \times QE \times Pa$ (3-11)

Fg:開口率 QE:量子効率 Pa:アバランシェ確率

受光感度から求める検出効率 (PDEcurrent)は式 (3-12)で表されます。

$$\mathsf{PDEcurrent} = \frac{1240}{\lambda} \times \frac{\mathsf{S}}{\mathsf{M}} \cdots \cdots (3-12)$$

λ: 入射光の波長 [nm]

PDEcurrentにはクロストークやアフターパルスが含ま れているため、PDEよりも高くなります。

[図3-9] 分光感度特性 (S13360-3025CS)



KAPDB0230JC

[図3-10] 受光感度-オーバー電圧 (S13360-3025CS)



KAPDB0231JB

[図3-11] 検出効率-波長 (S13360-3025CS)



KAPDB0259JB

[図3-12] 検出効率-オーバー電圧 (S13360-3025CS)



KAPDB0233JB

3-8 時間分解能

MPPCの各ピクセルにおいて光入射後から信号が出 力されるまでの時間には、配線長の違いなどによってバ ラツキが生じます。このバラツキはTTS (Transit Time Spread)と呼ばれます。MPPCに印加する逆電圧が大き くなると、TTSは小さくなり改善します。

[図3-13] TTS-オーバー電圧 (S13360-3050PE)



4. 測定例

MPPCの特性の測定例について、以下に示します。

4-1 増倍率

(1) チャージアンプによる測定

MPPCがフォトンを検出したときの出力電荷量から、増 倍率を見積もることができます。図4-1は、チャージアンプ を用いて増倍率を測定する接続例を示します。

[図4-1] 増倍率測定用の接続例 (チャージアンプを使用)



アッテネータで十分に減光したパルス光をMPPCに照 射し、出力電荷量の度数分布を取ると図4-2のような出力 結果が得られます。

[図4-2] 出力電荷量の度数分布例



KAPDB0136JA

図4-2において、曲線のピークは左からペデスタル、 1フォトン、2フォトン~を示します。ペデスタルは、出力の 基準となります。この例は、MPPCが1フォトン、2フォトン を中心として検出していることを表しています。隣り合う ピークの間隔は、1フォトン検出分の電荷量に相当しま す。増倍率(M)は式(4-1)で表されます。

M = <u>隣り合うピーク間の電荷量差</u> ……… (4-1) q

q:1電子当たりの電荷量

また、式(4-1)を用いて増倍率-逆電圧グラフを作成 し、外挿することで増倍率1の逆電圧、すなわち降伏電 圧 VBRを求めることができます。

(2) dl/dV法による測定

MPPCの出力電流-逆電圧特性を図4-3に示します。 出力電流を逆電圧で微分した関数 [式 (4-2)]に極大値 を与える電圧をVpeakとすると、Vpeak - VBRは型名ごと にほぼ一定ですが、VpeakとVBRのそれぞれの値は同型 名の場合でも素子ごとに異なります。あらかじめ、ある型 名におけるVpeak - VBRを求めておくと、特定の素子に ついてVpeakを測定することによってVBRを推定すること ができます。

[図4-3] 出力電流-逆電圧 (S13360-3050CS)



$$\frac{d}{dV_R}\log(I) = \frac{dI}{dV_R} \times \frac{1}{I} \quad \dots \dots \quad (4-2)$$

VR: 逆電圧 [V]



増倍率 (M)は、式 (4-3)で表すことができます。

$$M = \frac{C \times (V_R - V_{BR})}{q} \quad \dots \dots \quad (4-3)$$

```
C : ピクセル容量 [F]
VBR:降伏電圧 [V]
g :1電子当たりの電荷量 [C]
```

ピクセル容量は一定であるため、増倍率はdI/dV法に よって求めた降伏電圧と逆電圧から求められます。ただ し、推奨動作電圧から大きく外れた高い動作電圧を印 加した場合には、アフターパルスやクロストークなどのノ イズ成分が大きくなり、正確な測定ができなくなります。

4-2 ダークカウントレート

MPPCを暗箱の中に設置して、出力パルスをカウンタ に入力します。あらかじめ決めておいた閾値(0.5 p.e.な ど)を超える出力パルスのイベントの回数をカウントする ことによって、ダークカウントレートを求めることができま す。なお、MPPCの出力パルス幅は数十nsと非常に短い ため、広帯域のアンプを使用する必要があります。

[図4-5] ダークカウントレート測定用のブロック図



4-3 クロストーク

閾値をたとえば0.5 p.e.と1.5 p.e.に設定して、閾値を 超えたダークパルスのカウントレートを測定することに よって、それぞれの閾値におけるダークカウントレート N0.5 p.e.、N1.5 p.e.を求めることができます。クロストーク確 率 Pcrosstalkは、式 (3-4)によって測定できます。

さらに、閾値を掃引するとダークカウントレートのプロットは 図4-6のようになります。ダークカウントレートが急激に減少 する閾値電圧は、左から1フォトン、2フォトン~のパルス高さ に対応します。このグラフからNo.5 p.e.、N1.5 p.e.、N2.5 p.e.~を 求められます。



4-4 アフターパルス

ダークパルスの発生はランダムであり、ダークパルスが 発生する時間間隔は指数分布に従います。ダークパルス 発生時間間隔 Δtdark (単位: s)は式 (4-4)で表されます。

$$\Delta t_{dark} \propto exp\left(\frac{\Delta t}{\tau_{dark}}\right) \cdots (4-4)$$

τdark: ダークパルス発生の時定数 [s]

アフターパルスの発生時間間隔は、複数の指数分布 の和で表されます。アフターパルス発生時間間隔 Δtap (単位: s)は式 (4-5)で表されます。

$$\Delta t_{AP} \propto \sum_{k} Ak \times exp\left(\frac{\Delta t}{\tau k}\right) \dots (4-5)$$

k : Δtapを構成する時定数の数 Ak: 定数 τk: アフターパルス発生の時定数 [s]

rdarkとrkは著しく異なるため(rdark≫rk)、あるパル スが発生してから次のパルスが観測されるまでの経過 時間 Δtのヒストグラムを作成し、アフターパルスを含ま ない時間領域でダークパルス成分を見積もります。ヒス トグラム全体からフィッティングした成分を差し引くこと により、アフターパルス成分を求めることができます。

測定の際には、ディスクリミネータ・TAC・MCAを使 うことによって、前述のヒストグラムを作成することがで きます。MPPCへのフォトン入射により得られる出力信 号はアンプで増倍されディスクリミネータへ送られます。 ディスクリミネータはフォトン検出の閾値に達したレベル の信号を受け取るとTACへ信号を送ります。MPPCから 次の信号が出力されると、同様にしてTACへ信号が送ら れます。ここでTACは、初めの出力信号と次の出力信号 との時間間隔に比例した振幅のパルスを出力します。 MCAはTACから受け取ったパルスをその高さに応じて 分類し、チャンネルに分けていきます。MCAに蓄積され たデータはΔtのヒストグラムとなります。

[図4-7] アフターパルス測定の接続例



受光感度を測定するためには、まず単色光源からの 光を暗箱中の校正済みの光検出器で検出し、その出力 値から光検出器への入射光量(単位:W)を求めます。 次に、光検出器の代わりにMPPCを用いて同様に測定を 行い、MPPCの光電流(単位:A)を測定します。これらの 測定結果から、受光感度(S)を式(4-6)より求めます。



[図4-8] 受光感度測定の接続例



-6 検出効率

検出効率を測定するには、図4-9のようにパルス光源 を用います。パルス光源から出た単色パルス光をアッテ ネータで減衰させた後に積分球で反射し、校正済みフォ トダイオードおよびMPPCへ光を入射します。校正済み フォトダイオードからの出力電流を電流計で取得し、そ の値からMPPCへの入射フォトン数を求めます。⁴⁾

[図4-9] 検出効率測定の接続例



パルス光源からのトリガ信号と同期してオシロスコー プでMPPCのデータ取得を行い、パルス光に対する MPPCの応答波形を測定します。その応答波形から MPPCの出力電荷量を取得します。この出力電荷量の 取得を多数イベントにおいて行い、図4-2のような出力電 荷量の度数分布を取得します。パルス光が微弱で1パル ス光当たりのフォトン数が数個のとき、この分布は理想 的にはMPPCの検出フォトン数を平均値にもつポアソン 分布に従います。しかし、一部のイベントにはダークパル スが含まれ、1 p.e.以上のイベントにはクロストークとアフ ターパルスの影響があるため、実際に測定される分布は ポアソン分布からは歪んだ分布となります。ペデスタル のイベントにはクロストークおよびアフターパルスの影響 がないため、このイベント数からダークパルスの影響を 補正することによりポアソン分布の平均値を取得するこ とができます。

ポアソン分布は式(4-7)で定義されます。

式 (4-7)でx=0の場合、ポアソン分布は式 (4-8)で表 されます。

$$P(n, 0) = e^{-n} \cdots (4-8)$$

式 (4-8)の左辺は、ダークパルス分の補正も含めると 式 (4-9)で表されます。

$$P(n, 0) = \frac{\left(\frac{N_{ped}}{N_{tot}}\right)}{\left(\frac{N_{ped}^{dark}}{N_{tot}}\right)} \dots \dots (4-9)$$

Nped:パルス光計測時の0 p.e.イベント数 Ntot : パルス光計測時の全イベント数 N^{dark}:ダーク状態の0 p.e.イベント数 N^{dark}:ダーク状態の全イベント数

MPPCの検出フォトン数(平均)nは式(4-10)で表さ れます。nを入射フォトン数で割ることによって、検出効率 を求めることができます。





図4-10はTTS法による時間分解能の測定装置例で

す。パルス光源はフォトンを出すと同時にTACへ開始信 号を送ります。開始信号を受け取ったTACは、時間測定 を開始します。一方、MPPCへのフォトン入射により得ら れる出力信号はアンプで増倍されディスクリミネータへ 送られます。ディスクリミネータはフォトン検出の閾値に 達したレベルの信号を受け取るとTACへ信号を送りま す。TACはディスクリミネータからの信号を時間計測の 停止信号として受け取ります。ここでTACはフォトンが入 射してから出力するまでの時間に比例したパルスを出力 します。MCAはTACから受け取ったパルスをその高さに 応じて分類し、チャンネルに分けていきます。MCAに蓄 積されたデータはMPPCの応答のヒストグラムとなり、時 間分解能はこのヒストグラムの半値幅(FWHM)で表さ れます。

[図4-10] 時間分解能測定の接続例



KAPDC0030JA

[図4-11] TTS (代表例)



4-8 ダイナミックレンジ

(1) 同時に入射したフォトンに対するダイナミックレンジ

同時に入射したフォトンについてのダイナミックレンジ は、MPPCのピクセル数と検出効率によって決まります。 入射フォトン数が多くなると、1ピクセルに2個以上のフォ トンが入り始めます。1ピクセルに2個以上のフォトンが 入射しても、フォトン入射のオン・オフ判定しかできませ ん。そのため、入射フォトン数が多くなると直線性が悪化 します。



ダイナミックレンジを広くするためには、同時に入射す るフォトンに対して十分なピクセル数をもったMPPC (大 受光面サイズまたは小ピクセルピッチのタイプ)を使う必 要があります。

[図4-12] 同時に入射するフォトンに対するダイナミックレンジ (ピクセルピッチ: 15 µm)



KAPDB0238JB

(2) フォトンカウンティングのダイナミックレンジ

MPPCの励起ピクセル数は、式 (4-12)で表されます。

Nfired = Nphoton × PDE (4-12)

入射フォトン数が多くなると、複数の出力パルスが重 なるためカウント数に誤差が生じ、直線性が悪化します。 直線性は、パルスペア分解能と呼ばれるパラメータで 決定されます。パルスペア分解能は、MPPCの回復時間 (「4-9 回復時間」参照)と読み出し回路の特性によって 決まります。パルスペア分解能を考慮したMPPCの励起 ピクセル数は、式(4-13)で表されます。

| Nfired = | Nphoton × PDE | (4-13) |
|----------|---|--------|
| | $1 + Nphoton \times PDE \times Tresolution$ | |

Tresolution: パルスペア分解能

ダイナミックレンジを広くするためには、回復時間の短いMPPCを選択する必要があります。

[図4-13] フォトンカウンティングのダイナミックレンジ (S14160-3010PS)



KAPDB0239JB

(3) 電流測定のダイナミックレンジ

MPPCの光電流 (IMPPC)は、式 (4-14)で表されます。

 $I_{MPPC} = Nphoton \times PDEcurrent \times M \times q \dots (4-14)$

 PDEcurrent:
 受光感度から求める検出効率

 M
 :
 増倍率

 q
 :
 1電子当たりの電荷量

入射フォトン数は、入射光量(単位:W)を用いて、式 (4-15)で表されます。

入射光量が多くなると、1ピクセルに2つ以上のフォト ンが入射したり、同じピクセルに回復時間内にフォトンが 入射することが増えてきます。これが直線性の低下を招 きます。これらを考慮したMPPCの出力電流 Imppcは式 (4-16)で表されます。

$$I_{MPPC} = \frac{Nphoton \times PDEcurrent}{1 + \frac{Nphoton \times PDEcurrent \times T_{R}}{Ntotal}} \times M \times q \cdots (4-16)$$

TR: 回復時間 [S]

大光量の入射時には、素子が発熱して増倍率が低下 することによって、直線性が悪化することがあります。また 出力電流が多く流れるため、使用する保護抵抗によって はMPPCに印加される逆電圧が低下する場合がありま す。このため適切な値の保護抵抗を使用する必要があり ます。

[図4-14] 出力電流-入射光量 (S14160-3010PS)



ピクセルの増倍率が100%回復するために必要な時間(回復時間)は、受光面サイズとピクセルサイズによっ て異なります。図4-15にS14160-1315PSの特定の1ピク セルに、パルスの回復時間と同じ間隔で光が入射したと きの出力を示します。パルスが100%の高さまで回復して いることが分かります。

[図4-15] パルスレベルの回復 (S14160-1315PS)



出力パルスが完全に回復する前に次の入力パルスが 入射したときには、動作電圧で設定した増倍率に満たな い小さいパルスが出力されます。図4-15のパルスの立ち 上がり部分はピクセルの充電過程であり、充電が完了し ないうちに次のフォトンを検出した場合、その充電レベル に応じた大きさのパルス出力となります。

図4-16は、特定の1ピクセルに異なる周波数のパルス 光を入射したときの出力パルス形状を示します。光の入 射周波数を上げるにつれ、ピクセルの充電が十分にで きず、パルスの高さが低くなる様子がみられます。

[図4-16] 異なる周波数のパルス光を入射したときの出力パルス (S14160-1315PS)



時間

KAPDB0163JB

5. 使い方



MPPCの特性は、動作電圧や周囲温度によって大きく 変わります。一般に動作電圧を上げることによって素子内 部の電界強度が上がり、増倍率、検出効率、時間分解能 が向上しますが、一方でダークカウント、アフターパルス、 クロストークなどS/Nを低下させる成分が増加します。優 先すべき特性に合わせて、動作電圧を設定する必要があ ります。

MPPCは用途に応じて、さまざまな使い方をすることが できますが、ここではパルスを観測する場合の代表的な 使い方を紹介します。測定時には、広帯域のアンプとオシ ロスコープを使用すると便利です。図5-1に広帯域アンプ を接続する場合の接続例を示します。電源側の1 kΩ抵 抗・0.1 μFコンデンサは、電源の高周波ノイズを取り除く ためのローパスフィルタを構成します。1 kΩ抵抗は、過電 流に対する保護抵抗の役割も担います。MPPCは微弱光 検出器ですが、シンチレータとのカップリング時など、大光 量の光が入射する場合には大きな電流が流れ、保護抵 抗における電圧低下が顕著になることがあります。用途 に応じて、保護抵抗の値を設定する必要があります。な お、アンプはできるだけMPPCの近くに接続してください。

[図5-1] 接続例



MPPCの出力パルスの急峻な立ち上がりを活用した 計測を行う場合、広帯域のアンプとオシロスコープを選 定する必要があります。MPPCの出力パルスは数nsで立 ち上がるため、1 GHz程度でサンプリングを行えるような 機種を推奨します。狭帯域のアンプやオシロスコープを 使用すると、出力パルスになまりが生じ、正確な値が得ら れないことがあります。

5-2 デジタル方式・アナログ方式からの選択

MPPCに入射する光量によって、読み出し方式をデジ タル方式・アナログ方式から選択する必要があります。 入射光量の異なる場合のMPPCの出力をオシロスコー プで観測した波形を図5-2 (a)(b)(c)に示します。(a)(b) (c)の順で入射光量が多くなり、(a)は極微弱光を入射し た場合を示します。(a)の出力信号は離散したパルス形 状であり、この状態ではデジタル方式を選択して、信号を 2値化しパルス数をカウントする方が高S/Nの測定ができ ます。デジタル方式の場合、ダークカウントは減算が可能 なため、検出限界はダークカウントの揺らぎによって決ま ります。

入射光量が多くなると、出力波形はパルスが重なり 合った形状になります [(b)(c)]。この状態ではパルス数 をカウントできないため、アナログ方式を選択して、アナ ログ出力を測定し平均値を求めます。アナログ方式の検 出限界は、暗電流のショットノイズと読み出し回路の遮断 周波数により決まります。

図5-3は、デジタル方式・アナログ方式のそれぞれに 適した入射光量範囲 (受光面サイズ: □3 mm, ピクセル ピッチ: 50 μmの場合)を示します。

[図5-2] 出力波形

電圧

(a) 光量····小の場合 (極微弱光)





(b) 光量···中の場合





(c) 光量・・・大の場合



[図5-3] デジタル方式・アナログ方式に適した入射光量範囲 (冷却タイプ, 受光面サイズ: □3 mm, ピクセルピッチ: 50 µm)





MPPCモジュールは、MPPCを内蔵した微弱光検出モジュールです。フォトンカウンティングレベル~nWレベル の広い光量範囲の計測が可能なラインアップを用意し ています。MPPCの動作に必要なアンプと高圧電源回路 を搭載しており、電源(±5 Vなど)を供給するだけで測 定が可能です。比較的入射光量が多い用途向けの、温 度補償機能を搭載し安定した計測が可能なアナログ出 力タイプの非冷却型、フォトンカウンティング用に低ダー クカウントを実現したデジタル出力タイプの電子冷却型 などを用意しています。お客様の要望する仕様に合わ せたカスタム対応も可能です。詳細は、「MPPCモジュー ル」技術資料を参照してください。

[図5-4] MPPCモジュール

(a) アナログ出力タイプ 非冷却型 C13365シリーズ (b) デジタル出力タイプ 電子冷却型 C13366-GDシリーズ





6. 応用例

6 - 1 LiDAR (Light Detection and Ranging)

KAPDC0688JB

対象物にレーザ光を照射し、その反射光を光センサで とらえて距離を測定します。自動車の自動運転化に向け た取り組みが進む近年、LiDARは高度運転支援システ ム (ADAS: Advanced Driver Assistance System)、無人 搬送車 (AGV: Automatic Guided Vehicle)などに利用 されています。





360°に配置されたAPDまたはMPPCが対消滅γ線を 検出し、癌などのターゲットの位置をとらえます。APDと MPPCは磁場の影響を受けないため、MRIと組み合わ せて使用することも可能です。



KACCC0745JA

蛍光計測 - 3

試薬の微弱な蛍光発光をMPPCで検出することがで きます。



高エネルギー実験 6 - 4

究極の物質構造を解明するための高エネルギー加 速器実験において、MPPCが使用されています。欧州原 子核研究機構 (CERN)は、次世代線形加速器実験 ILC (International Linear Collider)の粒子エネルギーを検 出するカロリメータ部にMPPCを採用することを検討し ています。また、高エネルギー加速器研究機構 (KEK) と日本原子力研究開発機構 (JAEA)が共同で東海村 (茨城県)に建設を進めている大強度陽子加速器施設 (J-PARC)においては、ニュートリノが質量をもつかどう かを検証するため、スーパーカミオカンデ (岐阜県)へ向 けてニュートリノビームを送って観測するT2K (Tokai to Kamioka)実験が行われています。この実験では、ニュー トリノビームのモニタ用にMPPC (62000個)が採用され ています。 山村和久, 里健一, 鎌倉正吾, 大須賀慎二 "MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol.27 No.1 January 2009" MPPC の製品紹介と開発状況 (2009)
 K. Sato, K. Yamamoto, K. Yamamura, S. Kamakura, S. Ohsuka et al., Application Oriented Development of Multi-Pixel Photon Counter (MPPC), 2010 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record (2010)
 T. Nagano, K. Yamamoto, K. Sato, N. Hosokawa, A. Ishida, T. Baba et al., Improvement of Multi-Pixel Photon Counter (MPPC), 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record (2011)
 Patrick Eckert, Hans-Christian Schultz-Coulon, Wei Shen, Rainer Stamen, Alexander Tadday et al., Characterisation Studies of Silicon Photomultipliers, http://arxiv.org/abs/1003.6071v2

■ 参考文献

MPPCは、浜松ホトニクス株式会社の登録商標です。

本資料の記載内容は、令和7年2月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合が あります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、 天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

| 仙台営業所 | 〒980-0021 | 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階) | TEL (022) 267-0121 | FAX (022) 267-0135 |
|--------|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 東京営業所 | 〒100-0004 | 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階) | TEL (03) 6757-4994 | FAX (03) 6757-4997 |
| 中部営業所 | 〒430-8587 | 浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル) | TEL (053) 459-1112 | FAX (053) 459-1114 |
| 大阪営業所 | 〒541-0052 | 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階) | TEL (06) 6271-0441 | FAX (06) 6271-0450 |
| 西日本営業所 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階) | TEL (092) 482-0390 | FAX (092) 482-0550 |
| | | | | |

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市中央区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184

Cat. No. KAPD9008J05 Feb. 2025 DN